

## **Design and Simulation of a Bulk Driven Operational Trans-Conductance Amplifier Based on CNTFET Technology**

**Sayed Mohammad Ali Zanjani<sup>1,2</sup>, Assistant Professor, Mostafa Parvizi<sup>1,2</sup>, M.SC**

<sup>1</sup> Department of Electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

<sup>2</sup> Smart Microgrid Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

sma\_zanjani@pel.iaun.ac.ir

mostafa\_parvizi@sel.iaun.ac.ir

### **Abstract:**

In this paper, a new two-stage OTA is proposed which meeting the needs of high gain, low power and low noise, and designed based on the gm/ID technique with bulk driven method. It is noteworthy that due to the limitations of CMOS technology, CNTFET technology used for the circuit designs. Moreover, to improve the linearity of the circuit, triode transistors used in both stages of amplifiers. The simulation results of the proposed OTA are performed under 1V of supply voltage and 1pF of load capacitors in the HSPICE tool. According to the simulation results, the proposed circuit consumes less than 27  $\mu$ W of power and offers a high gain of 98 dB. The CMRR and PSRR values of the proposed circuit are 121 dB and 152 dB, respectively. The input referred noise is 0.92 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$  and the slew rate of the proposed circuit is 111 V/ $\mu$ s, which shown the better figure of merit (FOM) in comparison with the previous works.

**Keywords:** Operational trans-conductance amplifier, Carbon nanotube field effect transistor, high gain, low power, gm/ID Technique.

**Received:** 8 October 2020

**Revised:** 20 November 2020

**Accepted:** 6 December 2020

**Corresponding Author:** Sayed Mohammad Ali Zanjani

**Citation:** S.M.A. Zanjani, M. Parvizi, "Design and simulation of a bulk driven operational trans-conductance amplifier based on CNTFET technology", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 12, no. 45, pp. 65-76, Spring 2021 (in Persian).

 DOR: [20.1001.1.23223871.1400.12.1.5.1](https://doi.org/10.1001.1.23223871.1400.12.1.5.1)

مقاله پژوهشی

## طراحی و شبیه‌سازی یک تقویت‌کننده ترانسانای عملیاتی راه‌اندازی شده از طریق بدنه مبتنی بر فناوری ترانزیستور اثر میدان نانولوله کربنی

سید محمد علی زنجانی<sup>۱،۲</sup>، استادیار، مصطفی پرویزی<sup>۱،۲</sup>، دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد

۱- دانشکده مهندسی برق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

۲- مرکز تحقیقات ریزشبکه‌های هوشمند، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

sma\_zanjani@pel.iaun.ac.ir

mostafa\_parvizi@sel.iaun.ac.ir

**چکیده:** در این مقاله، یک مدار تقویت‌کننده ترانسانای عملیاتی جدید دو طبقه پیشنهاد می‌شود که نیازهای بهره بالا، توان مصرفی پایین و نویز کم را برآورده می‌کند و بر اساس روش gm/ID و راه‌اندازی از طریق بدنه طراحی شده است. قابل ذکر است که طراحی‌های صورت گرفته مداری با توجه به محدودیت‌های فناوری CMOS، در فناوری CNTFET انجام شده است. همچنین به منظور بهبود خطینگی مدار، ترانزیستورهای تریودی در هر دو طبقه به کار برده شده است. شبیه‌سازی‌های مدار تقویت‌کننده ترانسانای عملیاتی پیشنهادی در نرم‌افزار HSPICE و با ولتاژ تغذیه یک ولت و خازن‌های بار یک پیکوفاراد انجام پذیرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، مدار پیشنهادی کمتر از ۲۷ میکرووات توان مصرف می‌کند و بهره بالای ۹۸ دسی‌بل را ارائه می‌دهد. مقدار PSRR و CMRR مدار پیشنهاد شده به ترتیب برابر با ۱۲۱ دسی‌بل و ۱۵۲ دسی‌بل است. نویز ارجاع شده به ورودی مدار برابر با ۰/۹۲ نانو ولت بر رادیکال هرتز بوده و سرعت چرخش مدار برابر با ۱۱۱ ولت بر میکروثانیه است که نشان از بهتر بودن مقدار ضریب شایستگی مدار پیشنهادی در مقایسه با کارهای قبلی است.

**کلمات کلیدی:** تقویت‌کننده ترانسانای عملیاتی، ترانزیستور اثر میان نانولوله کربنی، بهره بالا، توان پایین، تکنیک gm/ID.

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۹/۷/۱۷

تاریخ بازنگری مقاله: ۱۳۹۹/۸/۳۰

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۹/۱۶

نام نویسنده‌ی مسئول: سید محمد علی زنجانی

نشانی نویسنده‌ی مسئول: نجف‌آباد- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد- دانشکده مهندسی برق

## ۱- مقدمه

تقویت‌کننده‌های ترانسانایی عملیاتی از طبقات اساسی در بسیاری از سامانه‌های آنالوگ و ترکیبی آنالوگ و دیجیتال هستند. این تقویت‌کننده‌ها با درجه‌های متفاوتی از پیچیدگی برای تحقق اهداف مختلف مانند تولید بایاس، تقویت با سرعت بالا، مدارهای کلید خازنی و فیلترها استفاده می‌شوند [۴-۱]. علی‌رغم پیشرفت فن‌آوری و ارتقاء روش‌های ساخت ترانزیستورهای ماسفت که منجر به کوچک‌تر شدن طول کانال و کاهش ولتاژ تغذیه شده است، متاسفانه ولتاژ آستانه ترانزیستورها تا مقدار زیادی ثابت باقی مانده است و طراحی را با چالش روبه‌رو کرده است. از طرفی با کاهش ولتاژ تغذیه، توان مصرفی، فرکانس کاری و بهره تقویت‌کننده کاهش یافته و اعوجاج هارمونیک کل و نویز افزایش یافته است. همچنین کاهش ولتاژ تغذیه و طول کانال سبب شده تقویت‌کننده‌های تک‌طبقه، به علت مقاومت خروجی کم و دامنه نوسانات پایین در خروجی با مشکل مواجه شوند [۵، ۶، ۱]. به منظور کاهش توان مصرفی از روش‌هایی مانند راه‌اندازی در ناحیه زیرآستانه و گیت شناور استفاده می‌گردد. اما این روش‌ها، نویزپذیری مدار را افزایش و بهره را کاهش داده است. به عنوان یک پیشنهاد، تقویت‌کننده‌های چندطبقه به طور گسترده جهت طراحی مدارهای OTA با بهره بالا استفاده شده‌اند اما با افزایش تعداد طبقات، تعداد قطب‌های تقویت‌کننده افزایش یافته و پهنای باند فرکانسی GBW کاهش می‌یابد. از این رو جهت افزایش فرکانس کاری و برقراری پایداری، این تقویت‌کننده‌ها به روش‌هایی جهت جبران‌سازی نیازمندند [۲، ۱]. طراحی تقویت‌کننده‌های ترانسانایی عملیاتی چندطبقه و جبران‌سازی فرکانسی آن‌ها یکی از چالش‌های اساسی طراحان است. متاسفانه، به منظور رسیدن به درجه‌ای از پایداری، عملکرد خوب دیگر پارامترها دچار مشکل می‌شود، لذا باید مصالحه‌ای بین این پارامترها برقرار کرد. در نتیجه، طراحی تقویت‌کننده‌ای که تمامی مشخصات را به اندازه مناسب داشته باشد، نیازمند طراحی خوب و روش جبران‌سازی بهینه است [۶].

از طرفی قابلیت اطمینان مدارهای نانومتری CMOS به دلایل متعددی کاهش یافته است. این دلایل عبارتند از: ۱- افزایش دمای ترانزیستور ۲- کاهش عملکرد کنترلی گیت ۳- افزایش جریان‌های مخرب زمان خاموشی یا جریان نشتی که منجر به افزایش توان ایستا می‌شود. ۴- تونل‌زنی الکترون‌ها ۵- کاهش نسبت جریان روشن به خاموش ترانزیستور. علاوه بر مشکلات ذکر شده، فرایند ساخت این ترانزیستورها به خصوص در هنگام عملیات لیتوگرافی، مراحل پیچیده‌تری دارد که باعث افزایش هزینه می‌گردد. از این رو، فناوری‌های جایگزین همچون ترانزیستورهای تک‌الکترونی و آتاماتای سلول‌های کوانتومی معرفی شده‌اند. هر چند تحقیقات وسیعی در حوزه الکترونیک دیجیتال توسط این فناوری‌ها ارائه شده است، اما متاسفانه این فناوری‌ها علاوه بر آن که محدودیت عملکرد دمایی دارند، هنوز در طراحی مدارهای آنالوگ جایگاهی ندارند [۲، ۱]. با این حال، ترانزیستورهای اثرمیدان نانولوله کربنی، به عنوان یکی از فناوری‌های جایگزین ترانزیستورهای MOSFET معرفی شده‌اند که مشخصه ولتاژ-جریان آن مشابه MOSFET است [۸، ۷]. از این رو بسیاری از تحقیقات حوزه دیجیتال توسط این فن‌آوری شبیه‌سازی شده است که می‌توان به حافظه‌های دستیابی ایستا به صورت تصادفی، واحدهای منطق و ریاضی از قبیل مدارهای جمع‌کننده، تفریق‌کننده، مالتی‌پلکسرها، مدارهای با منطق چند سطحی (سه سطحی و چهار سطحی)، مدارهای کمینه- بیشینه اشاره نمود [۹-۱۲]. با این حال، تعداد محدودی از مدارهای آنالوگ و سیگنال ترکیبی توسط این ترانزیستورها طراحی شده‌اند. مثلاً در سال ۲۰۱۹ یک مقاله جریان نسل دوم (CCII) مبتنی بر CNTFET طراحی شده است [۱۳]. در سال ۲۰۱۸ یک مدار تقویت‌کننده ابزار دقیق [۱۴] و یک مدار فیلتر چند منظوره [۱۵] و در سال ۲۰۲۰ یک مدار نمونه‌بردار و نگهدارنده [۱۶] مبتنی بر ترانزیستورهای CNTFET ارائه شده است. در مرجع [۱۷] یک مدار تقویت‌کننده دوطبقه متداول توسط ترانزیستورهای CNTFET مورد طراحی و شبیه‌سازی قرار گرفته است. این تقویت‌کننده با تغذیه  $\pm 0.9$  ولت، خازن بار ۱۰ پیکوفاراد و خازن جبران ۳ پیکوفاراد شبیه‌سازی شده است و دارای بهره ۴۹/۱۲ دسی‌بل، پهنای باند ۱۹۸ مگاهرتز و حاشیه فاز ۴۸ درجه است. همچنین در مراجع [۱۸] و [۱۹] دو تقویت‌کننده ترانسانایی عملیاتی با این ترانزیستورها طراحی و شبیه‌سازی شده است.

در این مقاله یک تقویت‌کننده دوطبقه ترانسانایی عملیاتی راه‌اندازی شده از طریق بدنه پیشنهاد، طراحی و شبیه‌سازی شده است. ساختار مقاله به این شرح است: در بخش دوم، چند مدار OTA (بالاخص با راه‌اندازی از بدنه) و روش‌های جبران فرکانسی آنها بررسی شده است. در بخش سوم مدار پیشنهادی معرفی می‌شود. نتایج شبیه‌سازی و مقایسه با تحقیقات قبلی در بخش چهارم و نتیجه‌گیری در بخش پنجم بیان شده است.

## ۲- مروری بر طراحی بهینه‌شده تقویت‌کننده ترانسانای عملیاتی

کاربرد وسیع تقویت‌کننده‌های ترانسانای عملیاتی در مدارهای مجتمع باعث شده است تا بخش زیادی از تحقیقات بر ارائه مدارها و روش‌هایی جهت بهبود پارامترها و عملکرد این تقویت‌کننده‌ها متمرکز گردد. به‌عنوان مثال، جهت افزایش بهره مدار از روش‌های فیدبک مثبت و افزایش بهره و یا مدارهای کسکود از قبیل کسکود تلسکوپ، کسکود تا شده و خودکسکود استفاده شده است [۲۰-۲۲]. روش فیدبک مثبت نیاز به دقت بالا در طراحی دارد و وابستگی زیادی به تغییرات ساخت و نیز تغییرات ولتاژ، دما و فرایند دارد. روش افزایش بهره سبب پیچیده‌شدن طراحی و اعمال صفر و قطب‌های ناخواسته به مدار می‌شود. مدارهای کسکود نیاز به ولتاژ تغذیه بیشتری دارند و با هدف طراحی در ولتاژ پایین و توان مصرفی کم مغایرت دارند؛ ضمن آن که دامنه نوسانات خروجی را نیز محدود می‌کنند [۱،۲].

تقویت‌کننده‌های دوطبقه و سه‌طبقه به‌منظور افزایش بهره و طراحی تقویت‌کننده‌های ابزار دقیق، از لحاظ ولتاژ تغذیه، قابلیت راه‌اندازی در ولتاژ پایین‌تری را نسبت به مدارهای کسکود دارند ولی نیازمند جبران‌سازی فرکانسی هستند. در جبران مدارهای دوطبقه، استفاده از خازن میلر، روش جبران پایه نامیده می‌شود [۲۳-۲۵]. استفاده از طبقه درین مشترک یا دنبال‌کننده سورس به‌عنوان بافر ولتاژ [۲۶] و استفاده از طبقه گیت مشترک به‌عنوان بافر جریان [۲۷] از دیگر روش‌های جبران فرکانسی تقویت‌کننده‌ها با دو قطب غالب هستند.

از طرفی طراحی در ناحیه زیرآستانه و از طریق بدنه نیز باعث می‌شود تا بتوان این مدارها را در ولتاژ تغذیه کمتری راه‌اندازی نمود و در نهایت توان مصرفی را خصوصاً در سامانه‌های قابل حمل که با باتری کار می‌کنند، کاهش داد. این در حالی است که مدار از لحاظ بهره، نویزپذیری و خطینگی دچار محدودیت می‌شود؛ ولی با استفاده از روش مداری تخصصی gm/ID، می‌توان این محدودیت‌ها را تا مقدار قابل قبولی کاهش داد [۲۸،۲۹]. اعمال سیگنال ورودی به گیت و اتصال بدنه به سورس در ساختار زوج تفاضلی، باعث محدودیت محدود ولتاژ حالت مشترک ورودی می‌شود. یک راه متداول برای رفع مشکل فوق، موازی کردن یک ترانزیستور NMOS با ترانزیستور PMOS ورودی است تا در هر لحظه حداقل یکی از ترانزیستورها روشن باشد. با این وجود، ساختار ترانزیستورهای موازی در ولتاژهای تغذیه بسیار پائین دچار مشکل می‌شود و هنگامی که محدودی ولتاژ حالت مشترک ورودی به نصف ولتاژ تغذیه می‌رسد، ترانزیستورهای ورودی وارد ناحیه خاموش می‌شوند. از این‌رو چندین راهکار برای طراحی مدارهای آنالوگ با ولتاژ و توان مصرفی پائین مورد استفاده قرار گرفته است؛ از جمله: عملکرد در ناحیه‌ی زیر آستانه، فن‌آوری گیت شناور، ساختار خودکسکود و راه‌اندازی از طریق بدنه [۳۰،۳۱].

لذا در این مقاله، طراحی و شبیه‌سازی یک تقویت‌کننده ترانسانای عملیاتی در فناوری CNFET و با استفاده از روش راه‌اندازی از طریق بدنه بررسی می‌شود به‌طوری‌که بهره‌ی بالا در توان مصرفی کم داشته باشد. همچنین مقادیر نویز ارجاع شده به ورودی مدار و سرعت چرخش مدار قابل توجه باشد.

## ۳- طراحی تقویت‌کننده پیشنهادی

شکل (۱) مدار تقویت‌کننده دوطبقه پیشنهاد شده بالک درایو با جبران‌سازی فرکانس از نوع بافر ولتاژ را نشان می‌دهد. طراحی مدار در چهار بخش زیر تشریح می‌شود.

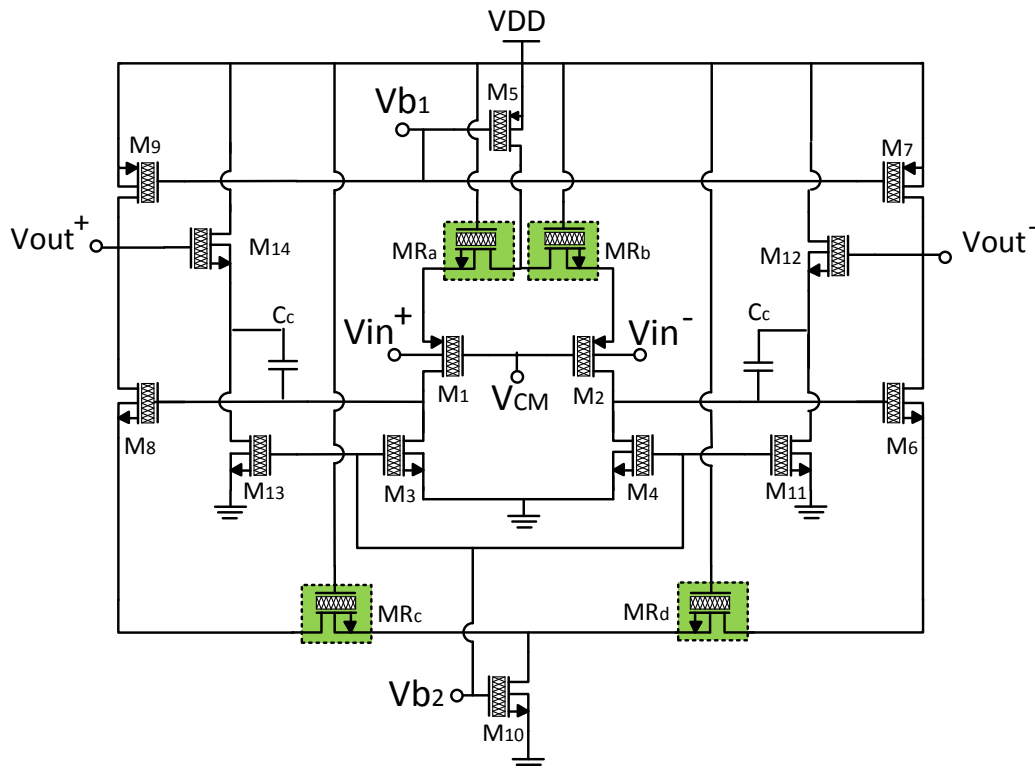
### ۳-۱- تعیین ولتاژ بایاس و جریان ترانزیستورهای طبقه اول

مدار اولیه شامل دو ترانزیستور ورودی  $M_1$  و  $M_2$  است که گیت آن‌ها به ولتاژ حالت مشترک  $V_{CM}$  متصل شده است. سیگنال ورودی به بدنه ترانزیستورها اعمال شده تا به‌صورت بالک درایو عمل نمایند.  $M_5$  در نقش منبع جریان  $I_{bias}$  با مقدار  $8/5$  میکروآمپر است.  $V_{DD}$  برابر ۱ ولت در نظر گرفته شده است. بنابراین طبقه ورودی  $8/5$  میکرووات توان مصرف می‌کند و جریان  $M_1$  و  $M_2$  نیز برابر با  $4/25$  میکروآمپر می‌باشد. سطح ولتاژ DC اعمالی به گیت  $M_1$  و  $M_2$  برابر  $0.5V_{DD}$  یا  $0.5$  ولت است. بردار کاپرال  $M_1$  و  $M_2$  برابر با (۱۹ و ۰) انتخاب شده تا قطر نانولوله‌ها طبق رابطه (۱) برابر با  $1/5$  نانومتر و ولتاژ آستانه آن‌ها براساس رابطه (۲) برابر با  $293$  میلی‌ولت باشد.

$$D_{CNT} \approx 0.0783 \sqrt{m^2 + n^2 + mn} \quad (1)$$

$$V_{TH} \approx \frac{0.436}{D_{CNT} \text{ (nm)}} \quad (2)$$

در حالی که  $m$  و  $n$  اعداد بردار کایرالیته هستند. بنابراین سطح ولتاژ DC پایانه سورس  $M_1$  و  $M_2$  نباید کمتر از  $793$  میلی‌ولت شود. اعداد کایرال برای  $M_5$  برابر با  $(200)$  انتخاب شده است تا دارای ولتاژ آستانه  $280$  میلی‌ولت می‌باشد. بنابراین ولتاژ بایاس  $V_{b1}$  برابر با  $0.7$  ولت می‌باشد. ضمناً ولتاژ درین  $M_5$  نباید کمتر از  $793$  میلی‌ولت و بیشتر از  $980$  میلی‌ولت شود، در غیر این صورت  $M_1$  و  $M_2$  وارد ناحیه زیرآستانه و خاموشی می‌شوند یا  $M_5$  وارد ناحیه خطی می‌شود. لذا تعداد نانولوله‌های  $M_5$  برابر  $9$  و فاصله بین آن‌ها  $25$  نانومتر انتخاب شده است. اعداد کایرال  $M_3$  و  $M_4$  برابر با  $(190)$  انتخاب شده است؛ پس  $V_{b2}$  برابر  $0.35$  ولت در نظر گرفته شده است تا این ترانزیستورها روشن باشند.



شکل (1): مدار تقویت‌کننده دوطبقه پیشنهادی با جبران بافر ولتاژ  
Figure 1: Proposed two-stage amplifier circuit with voltage buffer compensation

با توجه به توضیحات بالا، تعداد نانولوله‌های  $M_1$  و  $M_2$  برابر  $5$  و برای  $M_3$  و  $M_4$  برابر  $3$  انتخاب شده است. همچنین فاصله نانولوله‌ها به ترتیب  $20$  و  $10/5$  نانومتر در نظر گرفته شده است. بنابراین هر پنج ترانزیستور در ناحیه فعال هستند و جریان عبوری مدار  $8/5$  میکروآمپر و مصرف توان  $8/5$  میکرووات می‌شود. به منظور خطی‌سازی مدار، ترانزیستورهای  $MR_b$  و  $MR_a$  در ناحیه خطی و در نقش مقاومت، در سورس ترانزیستورهای ورودی قرار گرفته است.

### ۲-۳- تعیین ولتاژ بایاس و جریان ترانزیستورهای طبقه دوم

برای تعیین نقطه کار طبقه دوم همانند  $M_5$ ، می‌توان از ولتاژ بایاس  $V_{b1}$  برابر  $0.7$  ولت برای بایاس  $M_7$  و  $M_9$  استفاده نمود؛ بنابراین باید ولتاژ آستانه این ترانزیستورها در بیشترین مقدار خود کمتر از  $300$  میلی‌ولت باشد. لذا بردار کایرال این ترانزیستورها برابر  $(200)$  انتخاب شده تا ولتاژ آستانه آن‌ها  $280$  میلی‌ولت باشد. چون گیت  $M_6$  و  $M_8$  توسط خروجی طبقه اول راه‌اندازی شده است و این گره‌ها بر روی سطح  $475$  میلی‌ولت طراحی شدند، اعداد بردار کایرال این ترانزیستورها  $(130)$  انتخاب شده است تا ولتاژ آستانه آن‌ها حدود  $436$  میلی‌ولت به دست آید و این ترانزیستورها نیز روشن باشند.

ترانزیستورهای  $MR_c$  و  $MR_d$  با ولتاژ بزرگ در گیت و ولتاژ آستانه کم به راحتی وارد ناحیه خطی می‌شوند. انتخاب بردار (۲۸ و ۰) برای آن‌ها سبب می‌شود تا ولتاژ آستانه آن‌ها کمتر از 200 mV باشد و با ولتاژ گیت-سورس بیشتر از ۳۰۰ میلی‌ولت وارد ناحیه خطی شوند. ترانزیستور  $M_{10}$  را می‌توان همانند ترانزیستورهای  $M_3$  و  $M_4$  به  $V_{b2}$  برابر ۳۵۰ میلی‌ولت متصل نمود. پس لازم است ولتاژ آستانه این ترانزیستور کمتر از ۳۵۰ میلی‌ولت باشد.

برای تعیین نقطه کار طبقه دوم و دستیابی به بیشینه دامنه نوسانات خروجی و خط تاخط عمل کردن تقویت کننده، سطح ولتاژ مشترک خروجی  $0.5V_{DD}$  فرض می‌شود. در این قسمت جریان دو شاخه سمت چپ و راست مدار نیز طوری انتخاب شده است که هر شاخه ۷ میکروآمپر از منبع تغذیه، جریان کشیده و بدین ترتیب توان مصرفی طبقه دوم  $۲۲/۵$  میکرووات گردد.

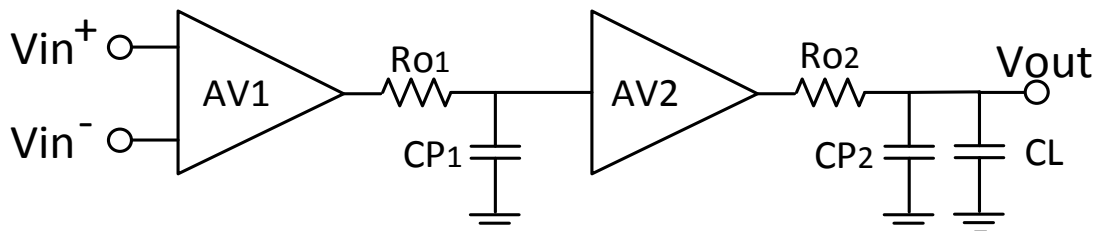
### ۳-۳- تعیین بهره، قطب‌ها و تابع تبدیل مدار

مقدار بهره ولتاژ برابر است با [۱]:

$$AV = AV_1 * AV_2 = \frac{gm_{1,2}}{1 + gm_{1,2}R_{a,b}} \frac{1}{g_{o_{3,4}}} \frac{gm_{6,8}}{1 + gm_{6,8}R_{c,d}} \frac{1}{gm_{7,9}} \approx \frac{ro_{2,4}ro_{7,8}}{R_{a,b}R_{c,d}} \quad (3)$$

منظور از  $gm_{1,2}$  ترانسایبیلی بدنه است. از آنجایی که مقاومت‌های خروجی ترانزیستورهای CNTFET در محدوده چند صد مگا اهم تا چند گیگا اهم هستند، این ترانزیستورها دارای بهره‌ذاتی بالایی هستند و می‌توان گفت رابطه (۳) بهره بزرگی ارائه می‌دهد به خصوص اینکه مقاومت‌های خطی‌سازی در محدوده چند کیلو اهم هستند.

شکل (۲) مدار طراحی شده را به صورت طبقاتی نشان می‌دهد که در آن  $Ro_1$  و  $Ro_2$  مقاومت خروجی طبقه اول و دوم است. خازن‌های پارازیتی گره خروجی طبقه اول و دوم با  $CP_1$  و  $CP_2$  نشان داده شده‌اند. با فرض این که خازن بار از خازن پارازیتی طبقه دوم بزرگتر است، در گره خروجی می‌توان تنها خازن  $CL$  را در نظر گرفت.



شکل (۲): مدل طبقاتی تقویت کننده دوطبقه طراحی شده با در نظر گرفتن مقاومت خروجی و خازن‌های پارازیتی  
Figure 2: Block diagram of two-stage amplifier designed considering the output resistance and parasitic capacitors

بنابراین قطب‌ها و تابع تبدیل مدار را می‌توان به صورت روابط (۴) تا (۶) بیان کرد:

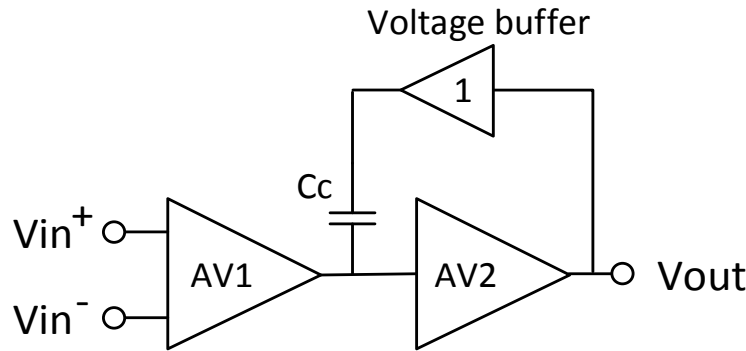
$$\omega_{p1} \approx \frac{1}{Ro1 \times CP1} \approx \frac{g_{o_{1,2}} + g_{o_{2,4}}}{CP1} \approx \frac{g_{o_{1,2}} + g_{o_{3,4}}}{cgs_{6,8}} \quad (4)$$

$$\omega_{p2} \approx \frac{1}{Ro2 \times (CP2 + CL)} \approx \frac{1}{Ro2 \times CL} \approx \frac{g_{o_{6,8}} + g_{o_{7,9}}}{CL} \quad (5)$$

$$H(s) \approx \frac{AV_1 \cdot AV_2}{(1 + \frac{s}{\omega_{p1}})(1 + \frac{s}{\omega_{p2}})} \quad (6)$$

### ۳-۴- طراحی مدار جبران فرکانسی از نوع بافر ولتاژ

در صورتی که مدار تقویت کننده دوطبقه طراحی شده به صورت یک تقویت کننده حلقه بسته با فیدبک منفی اجرا شود، در معرض ناپایداری قرار گرفته و نیاز به جبران‌سازی فرکانسی دارد. شکل (۳) نحوه جبران‌سازی فرکانسی با بافر ولتاژ را نشان می‌دهد.



شکل (۳): مدل طبقاتی تقویت‌کننده دوطبقه طراحی شده با جبران‌سازی بافر ولتاژ  
Figure 3: Block diagram of two-stage amplifier designed by voltage buffer compensation

در مدار شکل (۱) ترانزیستور  $M_{12}$   $M_{14}$  در نقش یک دنبال‌کننده سورس یا بافر ولتاژ عمل می‌کند. ترانزیستورهای  $M_{11}$  و  $M_{13}$  در نقش منبع جریان عمل می‌کنند و مقاومت خروجی بزرگی دارند. مقاومت خروجی یک دنبال‌کننده سورس برابر است با:

$$R_{outSF} \approx \frac{1}{gm_{12,14}} || ro_{11,13} \approx \frac{1}{gm_{12,14}} \quad (7)$$

تابع تبدیل مدار برابر است با:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-gm_{11,13}(ro_{6,8} || ro_{7,9})(ro_{1,2} || ro_{3,4})(gm_{12,14} + SC_C)}{aS^2 + bS + c} \quad (8)$$

در حالی که ضرایب  $a$ ،  $b$  و  $c$  برابرند با:

$$a = C_L C_C (ro_{6,8} || ro_{7,9}) (1 + gm_{12,14} (ro_{1,2} || ro_{3,4})) \quad (9)$$

$$b = (1 + gm_{11,13} gm_{12,14} (ro_{6,8} || ro_{7,9}) (ro_{1,2} || ro_{3,4})) C_C + gm_2 (ro_{6,8} || ro_{7,9}) C_L \quad (10)$$

$$c = gm_{12,14} \quad (11)$$

مکان هندسی تقریبی دو قطب مدار برابر است با:

$$\omega_{p1} \approx \frac{1}{gm_{11,13} (ro_{6,8} || ro_{7,9}) (ro_{1,2} || ro_{3,4}) C_C} \quad (12)$$

$$\omega_{p2} \approx \frac{gm_{11,13}}{C_L} \quad (13)$$

برای تعیین نقطه کار بافر می‌توان از گره خروجی شروع نمود. برای دستیابی به بیشینه دامنه نوسانات خروجی و خط تا خط عمل کردن تقویت‌کننده، سطح ولتاژ مشترک خروجی روی ۴۹۶ میلی‌ولت تنظیم شده است که به گیت ترانزیستورهای  $M_{12}$  و  $M_{14}$  اعمال می‌شود. در این قسمت، جریان مدار بافر در دو سمت چپ و راست مدار نیز طوری انتخاب شده است که هر شاخه ۱/۵ میکروآمپر جریان از منبع تغذیه کشیده و بدین ترتیب توان مدار بافر در دو سمت تقویت‌کننده ۳ میکرووات خواهد شد. پس توان مصرفی کل مدار تقویت‌کننده حدود ۲۲/۵ میکرووات می‌شود.

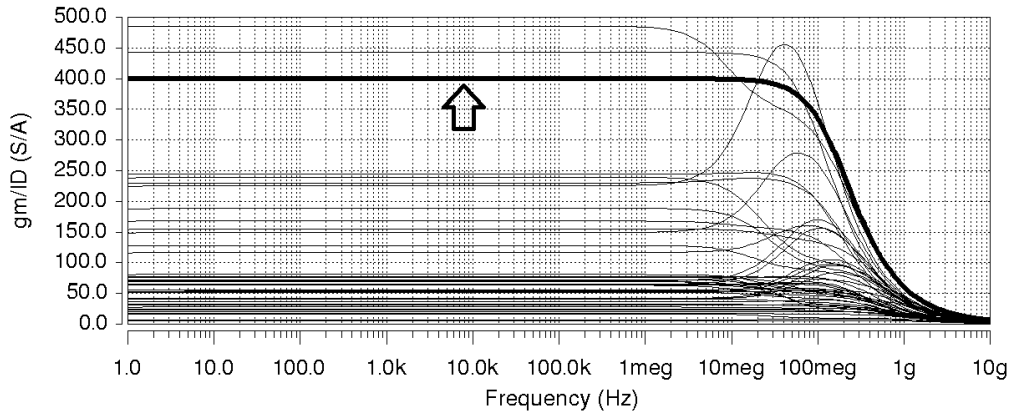
اگر ولتاژ سورس ترانزیستورهای دنبال‌کننده سورس ( $M_{12}$  و  $M_{14}$ ) را حدود ۱۰۰ میلی‌ولت در نظر بگیریم، لازم است ولتاژ آستانه این ترانزیستورها کمتر از ۳۹۶ میلی‌ولت باشد. لذا مقدار اعداد بردار کایرال ترانزیستورهای  $M_{12}$  و  $M_{14}$  برابر (۱۴ و ۰) انتخاب شده است تا قطر نانولوله‌ها برابر با ۱/۳۳ نانومتر و سطح ولتاژ آستانه آن‌ها برابر ۳۲۷ میلی‌ولت باشد.

اعداد بردار کایرال ترانزیستورهای  $M_{11}$  و  $M_{13}$  برابر با (۱۷ و ۰) انتخاب شده است تا قطر نانولوله‌ها برابر با ۱/۳۳ نانومتر و سطح ولتاژ آستانه برابر ۳۲۷ میلی‌ولت باشد. لذا باید حداقل ولتاژ گیت این ترانزیستورها ۳۲۷ میلی‌ولت باشند تا در مرز روشن/خاموش شدن قرار گیرند. لذا ولتاژ بایاس  $V_{b2}$  برابر ۰/۳۵ ولت، باعث می‌شود که این ترانزیستورها روشن باشند. تعداد نانولوله‌های  $M_{11}$  ( $M_{13}$ ) و  $M_{12}$  ( $M_{14}$ ) به ترتیب ۳ و ۶ عدد انتخاب شده است. همچنین فاصله بین نانولوله‌های این ترانزیستورها ۲۰ نانومتر در نظر گرفته شده است. با انتخاب این اعداد مدار بافر طراحی شده، جریانی به اندازه ۱/۶۵ میکروآمپر از منبع تغذیه می‌کشد.



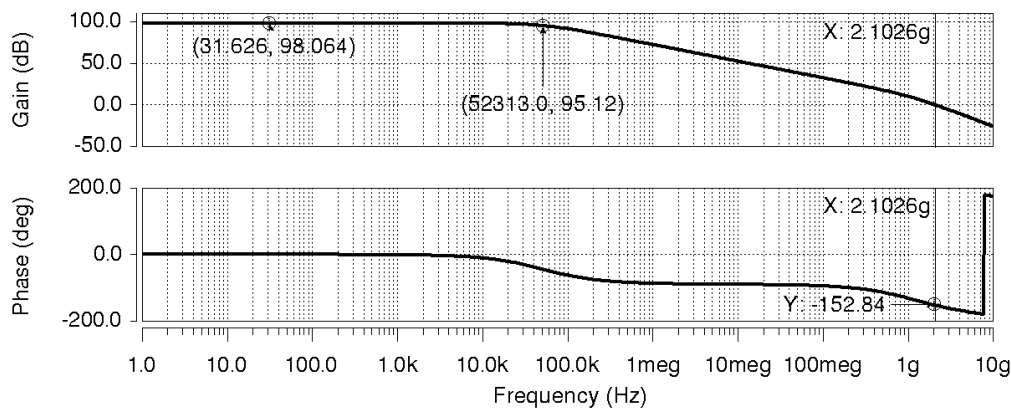
۴- شبیه‌سازی مدار پیشنهادی

مقادیر در نظر گرفته شده برای فاصله بین نانولوله‌ها در نرم‌فزار تغییر یافت تا مقدار بهینه gm/ID یافت شود. شکل (۴) نتیجه ۵۰ بار اجرای همزمان تحلیل مونت-کارلو و تغییرات گوسی ۵۰ درصدی برای فاصله بین نانولوله‌ها را نشان می‌دهد. با توجه به نتایج، مقدار gm/ID انتخابی در طراحی ۴۰۰ زیمنس بر آمپر انتخاب شده و شبیه‌سازی‌های انجام شده با دقت بالایی به مقادیر طراحی شده نزدیک است. مثلاً مقدار توان مصرفی مدار پس از شبیه‌سازی برابر با ۲۶/۷ میکرووات است در حالی که در زمان طراحی، توان مصرفی مدار ۲۵/۸ میکرووات بدست آمده بود. به عبارتی، شبیه‌سازی ۳/۴ درصد با مقادیر هدف در طراحی، متفاوت است.



شکل (۴): نتایج شبیه‌سازی مونت-کارلو روش gm/ID  
Figure 4: Monte Carlo simulation results of gm/ID method

شکل (۵) شبیه‌سازی مدار را بدون شبکه جبران‌ساز نشان می‌دهد. واضح است که مدار دارای ۹۸ دسی‌بل بهره فرکانس پایین است. پهنای باند مدار و فرکانس قطع مدار به ترتیب برابر با ۵۲ کیلوهرتز و ۲/۱ گیگاهرتز است و مدار با داشتن حاشیه فاز ۲۷ درجه، پایداری مناسبی ندارد و شیفت فاز دارد. شکل (۶)، نتیجه شبیه‌سازی پس از افزودن بافر ولتاژ است. همان‌گونه که در شکل نشان مشاهده می‌شود، حاشیه فاز مدار به حدود ۹۰ درجه افزایش یافته و مقدار فرکانس قطع مدار ۶۶ مگاهرتز است.

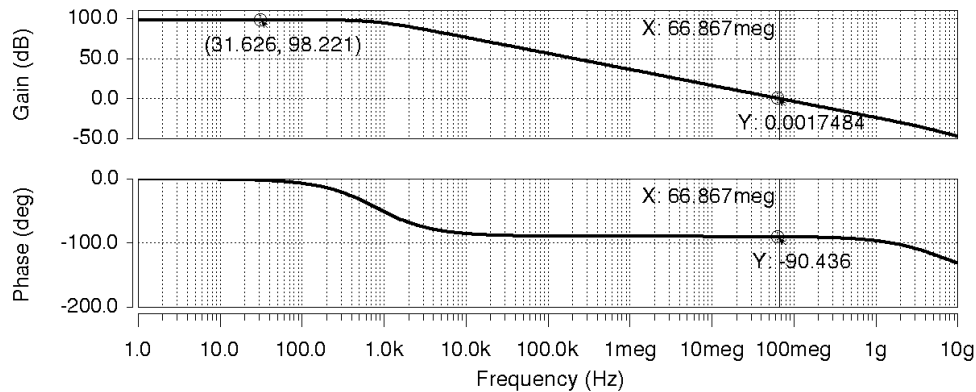


شکل (۵): نتیجه شبیه‌سازی بهره و فاز مدار تقویت‌کننده بالک-دراپو پیشنهادی بدون جبران‌سازی فرکانس  
Figure 5: The simulation result of the gain and phase of the proposed bulk driven amplifier circuit without frequency compensation

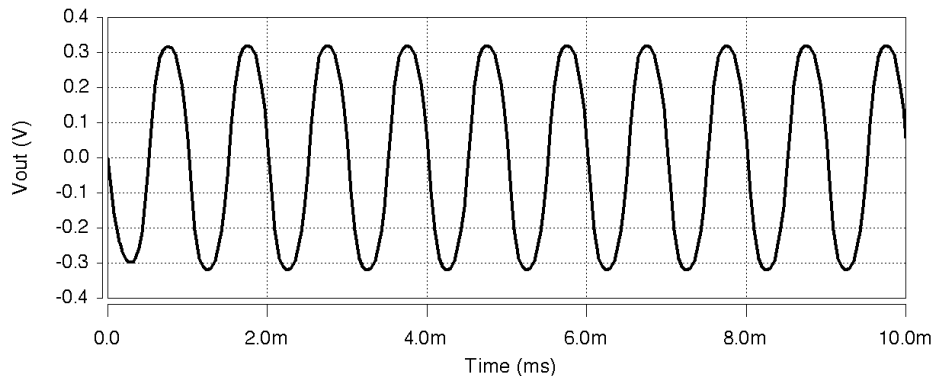
با توجه به این‌که بهره فرکانس پایین مدار ۹۸ دسی‌بل یا حدود ۸۵۰۰۰ است، اثر اعمال یک سیگنال سینوسی با دامنه ۸ میکروولت (قله تا قله) به ورودی مدار، منجر به سیگنال خروجی تفاضلی طبق شکل (۷) می‌شود. این در حالی است که نتیجه شبیه‌سازی تحلیل فوریه برای خروجی مدار نشان می‌دهد که مقدار اعوجاج هارمونیک کل برابر با THD با ۲/۷ درصد است. خروجی تحلیل FFT در شکل (۸) نشان داده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده هارمونیک‌های زوج در خروجی‌های تفاضلی



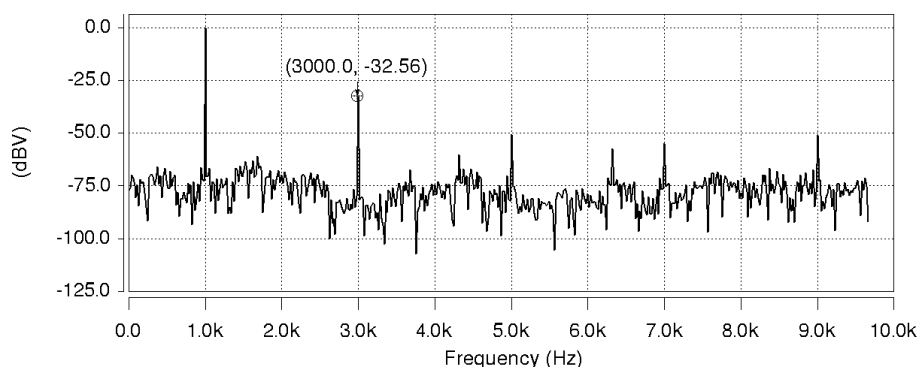
مدار کاملاً تضعیف شده و بزرگترین هارمونیک سوم  $HD_3$  با دامنه ۳۲- دسی‌بل است. مقدار سیگنال به نویز SNR برابر ۴۷ دسی‌بل و سیگنال به نویز و اعوجاج SNDR برابر ۳۲ دسی‌بل است.



شکل (۶): نتیجه شبیه‌سازی بهره و فاز تقویت‌کننده پس از جبران‌سازی  
Figure 6: Simulation result of gain and phase of amplifier after compensation

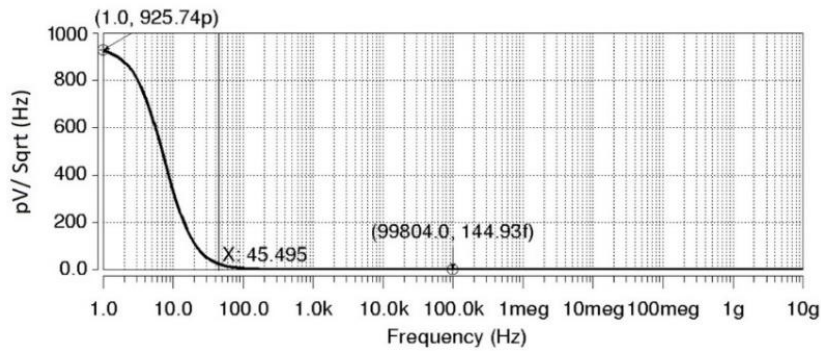


شکل (۷): سیگنال سینوسی خروجی با دامنه ۰/۶۴ ولت خط تاخط  
Figure 7: Output sine signal with an amplitude of 0.64 V<sub>pp</sub>



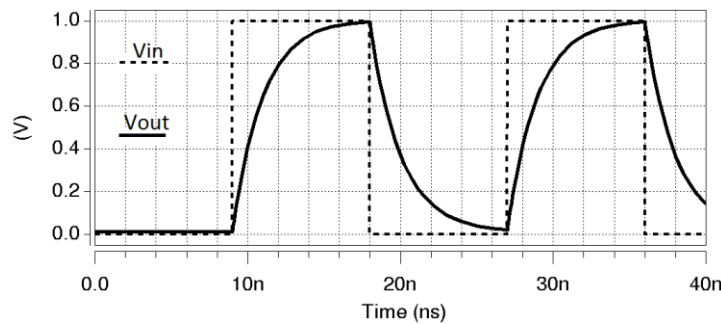
شکل (۸): نتیجه تحلیل فوریه و هارمونیک‌های خروجی  
Figure 8: The result of Fourier analysis and output harmonics

انتخاب  $gm/ID$  بزرگ یکی از راه‌های کاهش نویز در تقویت‌کننده‌ها است که در این طراحی استفاده شده است. طبق شکل (۹)، در فرکانس‌های پایین، نویز فلیکر کمتر از  $1 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$  شده است. می‌دانیم نویز فلیکر با فرکانس، رابطه عکس دارد، اما در فرکانس‌های بالا، نویز حرارتی، نویز غالب است که مقدار این نویز هم ناچیز است. مجموع نویز حرارتی و فلیکر مدار در فرکانس ۱ هرتز برابر با  $0.925 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$  و در فرکانس ۱۰۰ کیلوهرتز، نویز حرارتی برابر با  $144 \text{ fV}/\sqrt{\text{Hz}}$  است.



شکل (۹): نتیجه شبیه‌سازی نویز مدار پیشنهادی  
Figure 9: Result of noise simulation of the proposed circuit

نتیجه شبیه‌سازی نسبت رد حالت مشترک CMRR برابر ۱۲۱ دسی‌بل و نسبت رد منبع تغذیه PSRR بیشتر از ۱۵۰ دسی‌بل است. برای تعیین سرعت چرخش مدار طبق شکل (۱۰) یک سیگنال مربعی به ورودی تقویت‌کننده بهره واحد اعمال شده است و سیگنال ولتاژ خروجی اندازه‌گیری شده است. براساس نتیجه به‌دست آمده، در طی ۹ نانوثانیه، سیگنال خروجی به سیگنال ورودی رسیده است. بنابراین، این مدار دارای سرعت چرخش SR برابر ۱۱ ولت بر میکروثانیه است.



شکل (۱۰): نتیجه شبیه‌سازی مقدار سرعت چرخش  
Figure 10: Simulation result of slew rate value

### ۵- مقایسه با تحقیقات قبل و نتیجه‌گیری

در این بخش، نتایج بدست آمده از طراحی و شبیه‌سازی مدار پیشنهادی با کارهای قبلی مقایسه شده است. به‌منظور مقایسه، ضریب شایستگی مدار به‌صورت زیر تعریف شده است [۱۳]:

$$FOM \approx \frac{AV \times F_T}{Power \times Noise} \quad (14)$$

با توجه به جدول (۱) به دلیل مقدار بزرگ gm/ID در مدار پیشنهادی، نویز ورودی کاهش یافته و فرکانس بهره واحد مدار افزایش یافته است. همچنین بهره مدار طراحی شده تنها از بهره مدار مرجع [۳۲] کمتر است و از لحاظ فرکانس قطع، نسبت به مراجع [۱۸]، [۳۲] و [۳۳] مقدار بیشتری دارد. همچنین مدار پیشنهادی از لحاظ نویز، کمترین مقدار را دارد و از لحاظ سرعت چرخش، نسبت به سایر مراجع مقدار بهتری ارائه می‌دهد. با توجه به FOM تعریف شده، بهبود عملکرد مدار طراحی شده مشاهده می‌شود.

نتایج به‌دست آمده از طراحی و شبیه‌سازی مدار بالا به‌صورت خلاصه عبارتند از:

- ۱- استفاده از ترانزیستورهای نانولوله کربنی به‌دلایل مختلف مانند: دارا بودن کانال بالستیک، تحرک‌پذیری یکسان هر دو نوع ترانزیستور ( $\mu_n = \mu_p$ )، داشتن مشخصه جریان-ولتاژ مشابه ترانزیستورهای MOSFET، ولتاژ آستانه قابل تنظیم بالاخص در طراحی-های ولتاژ پایین، قابلیت جریان‌دهی بهتر به‌ازای ابعاد کوچکتر و ولتاژ تغذیه کمتر نسبت به ترانزیستورهای MOSFET باعث ارجحیت و بهبود مشخصات فنی مدار طرح پیشنهادی می‌شوند.

جدول (۱): مقایسه بین کارهای قبلی و مدار پیشنهاد شده

| پارامتر                 | مدار پیشنهادی           | [۱۴]                    | [۱۶]                   | [۱۸]                  | [۳۰]                         | [۳۳]                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Technology              | CNFET<br>32 nm          | CNFET<br>32 nm          | CNFET<br>32 nm         | CNFET<br>32 nm        | CMOS<br>180 nm               | CMOS<br>65 nm                |
| VDD                     | 1 V                     | $\pm 0.5$ V             | 1 V                    | 0.9 V                 | 0.5 V                        | 0.5 V                        |
| Power                   | 26.7 $\mu$ W            | 45.1 $\mu$ W            | 1000 $\mu$ W           | 125 $\mu$ W           | 70 nW                        | 3 $\mu$ W                    |
| Gain                    | 98 dB                   | 42.5 dB                 | 75 dB                  | 73 dB                 | 111.5 dB                     | 72 dB                        |
| $F_T$                   | 66 MHz                  | 491 MHz                 | 22 GHz                 | 5.12 MHz              | 9.5 KHz                      | 680 KHz                      |
| P.M.                    | 90°                     | 90°                     | 90°                    | 90°                   | 66°                          | 74°                          |
| CMRR                    | 121 dB                  | 86 dB                   | -                      | 70.9 dB               | 127.5 dB                     | 121 dB                       |
| PSRR                    | 152 dB                  | 59 dB                   | -                      | 93.8 dB               | 71 dB                        | 145 dB                       |
| S.R.                    | 111 V/ $\mu$ s          | 64 V/ $\mu$ s           | -                      | 4 V/ $\mu$ s          | 0.95 V/ms                    | 0.159 V/ $\mu$ s             |
| Input referred<br>Noise | 0.92<br>nV/ $\sqrt{Hz}$ | 22.5<br>nV/ $\sqrt{Hz}$ | 8.1<br>nV/ $\sqrt{Hz}$ | 13<br>nV/ $\sqrt{Hz}$ | 2.35<br>$\mu$ V/ $\sqrt{Hz}$ | 0.72<br>$\mu$ V/ $\sqrt{Hz}$ |
| THD                     | 2.7 %                   | 3.14 %                  | < 3 %                  | 0.14 %                | -                            | -                            |
| FOM                     | 263                     | 21                      | 203                    | 0.23                  | 6.43                         | 0.08                         |

۲- مقاومت خروجی ترانزیستورهای CNTFET خیلی بیشتر از مقاومت خروجی ترانزیستورهای MOSFET است. پس علاوه بر این که تاثیر پارامتر  $\lambda$  در جریان ترانزیستور ناچیز است، بهره ذاتی بالاتری دارند. همچنین ترانزیستورهای CNTFET مقدار  $gm/ID$  بالاتری دارند. به بیان دیگر، در نقطه کار یکسان و با جریان یکسان، ترانزیستورهای CNTFET دارای بهره ترانساینایی بیشتری هستند. این در حالی است که برای رسیدن به جریان یکسان، ابعاد ترانزیستور CNTFET کوچک‌تر است و در آخر منجر به کاهش سطح اشغالی و هزینه کمتر می‌شود. ضمناً جریان‌های مخرب در ترانزیستور CNTFET کمتر است و قابلیت اطمینان بیشتری دارند. به بیان دیگر، نسبت جریان حالت روشن به جریان حالت خاموش ( $I_{on}/I_{off}$ ) در ترانزیستورهای CNTFET بسیار بیشتر از ترانزیستورهای MOSFET است.

۳- در این مقاله یک تقویت‌کننده دوطبقه با بهره بالا و از طریق راه‌اندازی از طریق بدنه پیشنهاد شد و در جبران ناپایداری دیده شد که روش میلر، یک صفر ناخواسته در سمت راست صفحه ایجاد می‌کند که می‌تواند حاشیه‌فاز مدار را کمتر نماید. به همین دلیل نیاز به یک مقاومت حذف صفر (ترانزیستور خطی با دقت بالا) است. این در حالی است که با استفاده از روش‌های بافر ولتاژ و بافر جریان، توان مصرفی بیشتری به مدار تحمیل می‌گردد ولی می‌تواند منجر به بهبود پهنای باند شود.

۴- در این مقاله، روش طراحی  $gm/ID$  مطالعه شد؛ یعنی به کمک تحلیل مونت-کارلو و روش سعی و خطا، نسبت  $gm/ID$  مدار بهبود داده شد تا بهره مدار افزایش و نویز ارجاع شده به ورودی کاهش یابد. مقدار  $gm/ID$  مدار ۴۰۰ زیمنس بر آمپر انتخاب گردید و نتایج شبیه‌سازی مدار نشان می‌دهد که مدار در تغذیه ۱ ولت، بهره DC بیش از ۹۸ دسی‌بل ارائه می‌دهد و تنها ۲۶/۷ میکرووات توان مصرف می‌کند. به‌منظور جبران‌سازی فرکانسی از روش بافر ولتاژ یا دنبال‌کننده سورس استفاده شده است و نتایج شبیه‌سازی قبل از جبران‌سازی نشان می‌دهد که مدار پایداری بالایی ندارد. این در حالی است که پس از جبران‌سازی، مدار همچون تقویت‌کننده یک‌طبقه عمل می‌کند و در نتیجه حاشیه‌فاز تا ۹۰ درجه افزایش می‌یابد. فرکانس قطع، نویز ارجاع شده به ورودی و سرعت مدار به ترتیب برابر با ۶۶ مگاهرتز، ۰/۹۲ nV/ $\sqrt{Hz}$  و ۱۱۱ V/ $\mu$ s به‌دست آمده است. روش خطی‌سازی با مقاومت سورس سبب افزایش خطینگی مدار شده است و مقدار THD مدار در فرکانس یک کیلوهرتز و ولتاژ سینوسی خروجی با دامنه خط‌ناحخط بیش از ۶۰۰ میلی‌ولت برابر با ۲/۷ درصد است. نتایج به‌دست آمده فوق‌به‌علاوه مقدار CMRR برابر ۱۲۱ دسی‌بل و PSRR برابر ۱۵۲ دسی‌بل، کارایی این تقویت‌کننده را به‌طور کامل مشخص می‌کند؛ ضمن آن‌که مدار پیشنهادی به‌خوبی هارمونیک‌های زوج را حذف می‌نماید.

## مراجع

## References

- [1] B. Razavi, "Design of analog CMOS integrated circuits", Second Edition, New York, NY: McGraw-Hill, 2017.
- [2] D. A. Johns, K. Martin, "Analog integrated circuit design", First Edition, New York, John Wiley & Sons, 2008.
- [3] N. Dehabadi, R. Faghieh Mirzaee, "Ternary DCVS half adder with built-in boosters", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 11, no. 42, pp. 41-56, Summer 2020 (in Persian).
- [4] S. Tabakhi, F. Razaghian, "Wide tuning range gm-c low-pass filter optimization with 10 MHz cut-off frequency for wireless applications", Signal Processing and Renewable Energy, vol. 2, no. 3, pp. 15-20, Summer 2018.
- [5] S. Rezaei Borjlu, H. Alibagheri, "Design and simulation of a 20-watt doherthy power amplifier at a frequency of 2.14 GHz for wireless communication systems", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 10, no. 37, pp. 23-30, Spring 2019 (in Persian).
- [6] P. R. Gray, P. Hurst, R. G. Meyer, S. Lewis, "Analysis and design of analog integrated circuits", First Edition, New York, John Wiley & Sons, 2001.
- [7] F. Sharifi, A. Panahi, M. H. Moaiyeri, H. Sharifi, K. Navi, "High performance CNFET-based ternary full adders", IETE Journal of Research, vol. 64 no.1, pp. 108-115. Jan 2018 (doi: 0.1080/03772063.2017.1338-973).
- [8] P. Keshavarzian, R. Sarifkhani, "A novel CNTFET-based ternary full adder", Circuits, Systems, and Signal Processing, vol. 33, no. 3, pp.665-679, 2014 (doi: 10.1007/s00034-013-9672-6).
- [9] I. M. Salehabad, K. Navi, M. Hosseinzadeh, "Two novel inverter-based ternary full adder cells using CNFETs for energy-efficient applications", International Journal of Electronics, vol. 105, no. 10, pp.82-98, 2019 (doi: 10.1080/00207217.2019.1636306).
- [10] M. H. Bagheri, M. Bagherizadeh,; M. Moradi, M. H. Moaiyeri, "Design of CNTFET-based current-mode multi-input  $m: 3$  ( $4 \leq m \leq 7$ ) Counters". IETE Journal of Research, pp.1-11, 2018 (doi: 10.1080/03772063.2-018.1553640).
- [11] S. Tabrizchi, A. Panahi, F. Sharifi, K. Navi, N. Bagherzadeh, "Method for designing ternary adder cells based on CNFETs", IET Circuits, Devices & Systems, vol. 11, no.5, pp. 465-470, 2017 (doi: 10.1049/iet-cds.201-6.0443).
- [12] A. T. Mahani, P. Keshavarzian, "A novel energy-efficient and high-speed full adder using CNTFET", Microelectronics Journal, vol. 61, no. 1, pp. 79-88, 2017 (doi: 10.1016/j.mejo.2017.01.009).
- [13] M. Yasir, N. Alam, "Design of CNTFET-Based CCII Using gm/ID Technique for Low-Voltage and Low-Power Applications", Journal of Circuits, Systems and Computers, 29, no. 09, pp. 2050143, 2019 (doi: 10.1142/s0218126620501431).
- [14] S. M. A. Zanjani, M. Dousti, M. Dolatshahi, "High-precision, resistor less gas pressure sensor and instrumentation amplifier in CNT technology", AEU-International Journal of Electronics and Communications, vol. 93, pp. 325-336, 2018 (doi: 10.1016/j.aeue.2018.06.018).
- [15] S. M. A. Zanjani, M. Dousti, M. Dolatshahi, "Inverter-based, low-power and low-voltage, new mixed-mode Gm-C filter in subthreshold CNTFET technology". IET Circuits, Devices & Systems, vol. 12, no. 6, pp. 681-688, 2018 (doi: 10.1049/iet-cds.2018.5158).
- [16] H. Mahmoodian, M. Dolatshahi, "An energy-efficient sample-and-hold circuit in CNTFET technology for high-speed applications", Analog Integrated Circuits and Signal Processing, pp. 1-13, vol. 103, March 2020 (doi: 10.1007/s10470-020-01607-y).
- [17] P. A. Gowri sanNara, K. UdhayaNumarb, "A novel carbon nanotube field effect transistor based arithmetic computing circuit for low-power analog signal processing application", Procedia Technology, no.12, pp. 154-162, 2014 (doi: 10.1016/j.protcy.2013.12.469).
- [18] M. Yasir, N. Alam, "Systematic design of CNTFET based OTA and Op amp using gm/ID technique". Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol. 102, issue 2, pp. 293-307, 2020 (doi: 10.1007/s10470-019-01492-0).
- [19] M. Cen, S. Song, C. Cai, "A high performance CNFET-based operational transconductance amplifier and its applications", Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol. 91, issue 3, pp. 463-472, 2017 (doi: 10.1007/s10470-017-0951-1).
- [20] J. Mahattanakul, J. Chutichatuporn, "Design procedure for two-stage CMOS op amp with flexible noise-ower balancing scheme", IEEE Trans. on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 52, no. 8, pp. 1508-1514, 2005 (doi: 10.1109/tcsi.2005.851395).
- [21] B. Wen, Q. Zhang, X. Zhao, "A two-stage CMOS OTA with enhanced transconductance and DC-gain", Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol. 98, no. 2, pp. 257-264, 2019 (doi: 10.1007/s10470-018-1281-7).

- [22] Z. Yan, P. I. Mak, R. P. Martins, "Two stage operational amplifiers: Power and area efficient frequency compensation for driving a wide range of capacitive load", *IEEE Circuits and Systems Magazine*, vol. 11, no. 1, pp. 26-42, 2011 (doi: 0.1109/mcas.2010.939783).
- [23] M. Yavari, "Hybrid cascode compensation for two-stage CMOS opamps", *IEICE Trans. on Electronics*, vol. 88, no. 6, pp. 1161-1165, 2005 (doi: 0.1109/date.2006.244037).
- [24] L. H. Ferreira, T. C. Pimenta, R. L. Moreno, "An ultra-low-voltage ultra-low-power CMOS Miller OTA with rail-to-rail input/output swing", *IEEE Trans. on Circuits and Systems II: Express Briefs*, vol. 54, no. 10, pp. 843-847, 2007 (doi: 10.1109/tcsii.2007.902216).
- [25] D. Marano, A. D. Grasso, G. Palumbo, S. Pennisi, "Optimized active single-miller capacitor compensation with inner half-feedforward stage for very high-load three-stage OTAs", *IEEE Trans. on Circuits and Systems I: Regular Papers*, vol. 63, no. 9, pp. 1349-1359, 2016 (doi: 10.1109/tcsi.2016.2573920).
- [26] H. Veldandi, R. A. Shaik, "An ultra-low-voltage bulk-driven analog voltage buffer with rail-to-rail input/output range", *Circuits, Systems, and Signal Processing*, vol. 36, no. 12, pp. 4886-4907, 2017 (doi: 10.1007/s00034-017-0663-x).
- [27] J. Mahattanakul, "Design procedure for two-stage CMOS operational amplifiers employing current buffer", *IEEE Trans. on Circuits and Systems II: Express Briefs*, vol. 52, no. 11, pp. 766-770, 2005 (doi: 10.1109/tcsii.2005.852530).
- [28] S. K. Rajput, B. K. Hemant, "Two-stage high gain low power opamp with current buffer compensation", *Proceeding of the IEEE/GHTCE*, pp. 121-124, Shenzhen, China, Nov. 2013 (doi: 0.1109/ghtce.2013.67672-55).
- [29] J. Luo, L. Wei, C. S. Lee, A. D. Franklin, X. Guan, E. Pop, D. A. Antoniadis, H. S. P. Wong, "Compact model for carbon nanotube field-effect transistors including nonidealities and calibrated with experimental data down to 9-nm gate length", *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. 60, no. 6, pp. 1834-1843, 2013 (doi: 10.1109/ted.2013.2258023).
- [30] L. Zuo, S. K. Islam, "Low-voltage bulk-driven operational amplifier with improved transconductance", *IEEE Trans. on Circuits and Systems I: Regular Papers*, vol. 60, no. 8, pp. 2084-2091, 2013 (doi: 10.1109/tcsi.2013.2239161).
- [31] J. M. Carrillo, G. Torelli, M. A. Domínguez, J. F. Duque-Carrillo, "On the input common-mode voltage range of CMOS bulk-driven input stages", *International Journal of Circuit Theory and Applications*, vol. 39, no. 6, pp. 649-664, 2011 (doi: 10.1109/ecctd.2009.5274938).
- [32] B. Wen, Q. Zhang, X. Zhao, "A two-stage CMOS OTA with enhanced transconductance and DC-gain", *Analog Integrated Circuits and Signal Processing*, vol. 98, no. 2, pp. 257-264, 2019 (doi: 10.1007/s10470-018-1281-7).
- [33] H. Veldandi, R. A. Shaik, "Low-voltage PVT-insensitive bulk-driven OTA with enhanced DC gain in 65-nm CMOS process", *AEU-International Journal of Electronics and Communications*, vol. 90, pp. 88-96, 2018 (doi: 10.1016/j.aeue.2018.03.033).